

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 2 月 26 日 (2009.2.26)

【公開番号】特開 2007-242848 (P2007-242848A)

【公開日】平成 19 年 9 月 20 日 (2007.9.20)

【年通号数】公開・登録公報 2007-036

【出願番号】特願 2006-62495 (P2006-62495)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 21/318 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

H 0 1 L 23/52 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/28 B

H 0 1 L 21/318 A

H 0 1 L 29/78 6 1 6 K

H 0 1 L 29/78 6 1 6 U

H 0 1 L 21/28 3 0 1 R

H 0 1 L 21/88 R

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 1 月 9 日 (2009.1.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

基板上にモリブデンを含む層によって逆スタガード型 T F T のソース/ドレイン電極層を形成し、

前記モリブデンを含む層が露出した状態において、前記基板に対し、少なくとも窒素ガスを用いた大気圧プラズマ処理を行い、

前記大気圧プラズマ処理後、前記 T F T のチャンネルが露出した状態で洗浄を行なう基板の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 7】

基板上に形成された逆スタガード型 T F T のモリブデンを含むソース/ドレイン電極層において、

前記モリブデンを含むソース/ドレイン電極層の表面に形成されたモリブデン窒化物を有する配線基板。